

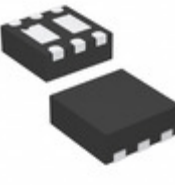
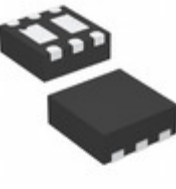

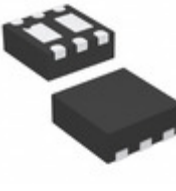
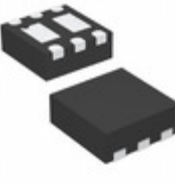
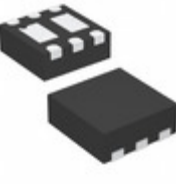

	<p><b>SIA511DJ-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIA511DJ-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N/P-CH 12V 4.5A SC70-6</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIA511DJ-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIA511DJ-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 12V 4.5A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 4.2A, 4.5V
Leistung - max	6.5W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Dual
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	400pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 8V
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A

SIA511DJ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIA511DJ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIA511DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIA511DJ-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIA483DJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 12A SC70-6</p>	 <p><b>SIA517DJ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 12V 4.5A SC-70-6</p>	 <p><b>SIA511DJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 12V 4.5A SC70-6</p>	 <p><b>SIA477EDJT-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 12A SC70-6</p>
 <p><b>SIA513DJ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 4.5A SC70-6</p>	 <p><b>SIA513DJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 4.5A SC70-6</p>	 <p><b>SIA517DJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 12V 4.5A SC-70-6</p>	 <p><b>SIA483DJ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 12A SC70-6</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIA511DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIA511DJ-T1-GE3 Datenblatt	SIA511DJ-T1-GE3-Datenblätter	SIA511DJ-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIA511DJ-T1-GE3
SIA511DJ-T1-GE3 Electronic	SIA511DJ-T1-GE3-Komponenten	SIA511DJ-T1-GE3-Verteiler	SIA511DJ-T1-GE3-Bild	SIA511DJ-T1-GE3-Teil
SIA511DJ-T1-GE3 Preis	SIA511DJ-T1-GE3 Hersteller	SIA511DJ-T1-GE3 Bild	SIA511DJ-T1-GE3 Aktie	SIA511DJ-T1-GE3 Inventar
SIA511DJ-T1-GE3 Neu	SIA511DJ-T1-GE3 Original	SIA511DJ-T1-GE3 garantiert	SIA511DJ-T1-GE3 RFQ	SIA511DJ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited